# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ** 

### Тонкопленочные структуры в электронике

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.04\_24\_00.plx

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4	8 (4.2)		того
Недель	8	3		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	16	16	16	16
Лабораторные	16	16	16	16
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25
Итого ауд.	32,25	32,25	32,25	32,25
Контактная работа	32,25	32,25	32,25	32,25
Сам. работа	31	31	31	31
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75
Итого	72	72	72	72

#### Программу составил(и):

к.т.н., доц., Гололобов Геннадий Петрович

Рабочая программа дисциплины

#### Тонкопленочные структуры в электронике

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 $\Phi$ ГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 26.01.2024 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 16.05.2024 г. № 11 Срок действия программы: 20242028 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

УП: 11.03.04\_24\_00.plx

## Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_2026 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

#### Промышленной электроники

Протокол от	2028 г. №
Зав. кафедрой	
зав. кафедрои	

2020 10

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1	Целью освоения дисциплины «Тонкопленочные структуры в электронике» является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в части изучения основ электрохимических и физико-химических методов получения тонкопленочных структур металлов и сплавов применительно к химии, теоретической и прикладной электрохимии, материаловедению; в выработке умения выбрать оптимальную методику анализа и грамотно оценить полученный результат.
1.2	Задачи дисциплины:
1.3	1) получение и закрепление теоретических и практических знаний в области физических и физико- химических явлений и процессов, лежащих в основе наиболее важных методов исследования состава, структуры и свойств материалов и покрытий и явлений в них;
1.4	2) понимание принципов работы и устройства типовых приборов и аппаратуры, используемых в данных методах, способов приготовления и подготовки образцов, обработки и анализа регистрируемых характеристик и источников возможных ошибок, определения точности экспериментов и их ограничений;
1.5	3) приобретение знаний и навыков по оценке возможностей методов и их практическому использованию в получении тонкопленочных структур различной природы, изучению процессов и явлений в них.

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ				
П	икл (раздел) ОП:				
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:				
2.1.1	Аналитические приборы и методы в электронике				
2.1.2	Интерфейсы и программирование вычислительных систем				
2.1.3	Научно-исследовательская практика				
2.1.4	Программирование и схемотехника микропроцессорной техники				
2.1.5	Производственная практика				
2.1.6	Цифровая электроника				
2.1.7	Электронные и ионные приборы				
2.1.8	Электронные цепи				
2.1.9	Схемотехника				
2.1.10	Тепловые процессы в электронике				
2.1.11	Технологическая (проектно-технологическая)				
2.1.12	Технология изделий микро- и наноэлектроники				
2.1.13	Электромагнитные поля и волны. Ч.2				
2.1.14	Твердотельная электроника				
2.1.15	Технологические процессы наноэлектроники				
2.1.16	Цифровая обработка сигналов в электронных устройствах				
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:				

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПК-2:** Способен анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

#### ПК-2.1. Анализирует научные данные, результаты экспериментов и наблюдений

#### Знать

Основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации.

#### Уметь

Выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования.

#### Владеть

Способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений.

ПК-2.2. Систематизирует и обобщает результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

УП: 11.03.04 24 00.plx стр.

#### Знать

Принципы работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники.

#### Уметь

Выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники. Проектировать тонкопленочные и полупроводниковые микросхемы и представлять отчеты по результатам исследований.

#### Владеть

Навыками выполнения работ по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники.

## ПК-3: Способен разрабатывать и анализировать технологические процессы изготовления устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

## ПК-3.2. Проводит анализ технических требований, предъявляемых к изделиям электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

#### Знать

Методы осаждения тонких пленок, процессы роста тонкопленочных покрытий.

#### Уметь

Проводить необходимые эксперименты, получать результаты, обрабатывать и анализировать их в рамках метода.

#### Владеть

Методами количественного структурного анализа, контроля качества и определения характеристик материалов и покрытий, а также основами сертификации материалов и покрытий.

#### В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:						
3.1.1	Основные понятия технологии плёночных изделий в электронике;						
3.1.2	Методы осаждения тонких пленок, процессы роста тонкопленочных покрытий;						
3.1.3	Область применения плёнок и плёночных структур в электронике; требования к контактным покрытиям;						
3.1.4	Методы и технологии формирования рисунка интегральных микросхем;						
3.1.5	Методы придания плёнкам требуемых свойств.						
	Уметь:						
3.2.1	Составлять технологический маршрут изготовления тонкопленочных и полупроводниковых микросхем;						
3.2.2	Проводить необходимые эксперименты, получать результаты, обрабатывать и анализировать их в рамках метода;						
3.2.3	Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;						
3.2.4	Эксплуатировать контрольно-измерительное измерительное оборудование для измерения параметров и характеристик материалов для производства изделий электроники;						
3.2.5	Оценивать поведение материала и причины отказов устройств электроники при воздействии на них различных эксплуатационных факторов: обоснованно выбирать материал и при необходимости его обработку для получения необходимой структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность элементов электронной техники.						
3.3	Владеть:						
3.3.1	С методами количественного структурного анализа, контроля качества и определения характеристик материалов и покрытий, а также основами сертификации материалов и покрытий;						
3.3.2	С навыками представления результатов исследования в форме научных отчетов, публикаций, презентаций.						

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля	
	Раздел 1. Основные понятия технологии плёночных изделий.						
1.1	Этапы развития и направления современной электроники. /Тема/	8	0				
1.2	Лекция 1 /Лек/	8	2	ПК-2.1-У	Л1.1 Л1.2Л2.1Л3. 3 Э1 Э3		
1.3	Применение плёнок и плёночных структур в электронике. Этапы разработки и изготовления плёночных изделий. /Тема/	8	0				
1.4	Лекция 2 /Лек/	8	2	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э3		

	Раздел 2. Методы нанесения пленок и покрытий.					
2.1	Катодное распыление. Механизм катодного распыления. Конденсация материала при катодном распылении. /Тема/	8	0			
2.2	Лекция 1 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	Л1.2 Л1.6Л3.1 Л3.3 Э2	
2.3	Лабораторная работа 1 /Лаб/	8	4	ПК-2.1-В	Л1.2 Л1.3Л3.4 Э4	
2.4	Нанесение плёнок методом электрического взрыва вещества. /Тема/	8	0			
2.5	Лекция 2 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В	Л1.2 Л1.3 Л1.5Л2.2Л3. 1 Л3.3 ЭЗ Э5	
2.6	Лабораторная работа 2 /Лаб/	8	4	ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2Л3.2 Л3.4 Э2 Э4	
2.7	Гальваническое нанесение плёнок. Химическое осаждение в электролитах. /Тема/	8	0			
2.8	Лекция 3 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.3 Л1.5Л3.2 Э1 Э5	
2.9	Лабораторная работа 2 /Лаб/	8	4	ПК-2.1-В ПК-2.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.6 ЭЗ Э4	
2.10	Плазмохимические методы нанесения плёнок. Способы нанесения и формирования наноструктур. /Тема/	8	0			
2.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	8	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	Л1.1Л3.2 Л3.3 Э3	
	Раздел 3. Функциональные материалы и покрытия в электронике.					
3.1	Газопоглотительные покрытия и материалы. Электроизоляционные покрытия. /Тема/	8	0			
3.2	Лекция 1 /Лек/	8	2	ПК-2.1-У	Л1.1 Л1.5Л3.1 Э1	
3.3	Эрозионно-стойкие покрытия электродов. Покрытия с высоким коэффициентом ион- электронной эмиссии. /Тема/	8	0			
3.4	Лекция 2 /Лек/	8	2	ПК-3.2-3	Л1.2Л2.1Л3. 3 Э2 Э4	
3.5	Лабораторная работа 1 /Лаб/	8	4	ПК-2.2-У	Л1.1Л2.1Л3. 3 Э3	
3.6	Контактные покрытия магнитоуправляемых контактов. Требования к контактным покрытиям (структура, фазовый состав, физико-механические и другие свойства). Технологии нанесения контактных покрытий. /Тема/	8	0			
3.7	Лекция 3 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.2Л2.1Л3. 2 Э3 Э4	
3.8	Контрольная работа /Зачёт/	8	3,75	ПК-2.1-В	Л1.3Л2.1Л3. 3 Э4	

3.9	Покрытия на основе золота. Многослойные покрытия. Барьерные слои. /Тема/	8	0			
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	6	ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.3 Л1.6Л3.3 Э2	
	Раздел 4. Тонкопленочные фотоэлементы.					
4.1	Фотоэлементы на основе кристаллических пленок кремния. /Тема/	8	0			
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.6Л2.1Л3. 3 Э3	
4.3	Технологический процесс изготовления тонкопленочных фотоэлементов. Просветление тонкопленочных фотоэлементов. /Тема/	8	0			
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	4	ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	Л1.2 Л1.4Л2.1 Э2	
	Раздел 5. Получение рисунка интегральных схем.					
5.1	Фотолитография. Способы экспонирования. /Тема/	8	0			
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4	ПК-2.1-У ПК-2.2-У	Л1.1 Л1.4 Л1.5 Э4 Э5	
5.3	Контрольная работа /Зачёт/	8	5	ПК-2.1-У ПК-2.1-В	Л1.2 Л1.4 Л1.5 Э2	
5.4	Оптические эффекты при фотолитографии. Методы и технология формирования рисунка интегральных микросхем. /Тема/	8	0			
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	5	ПК-2.1-В ПК-2.2-У	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э2	
5.6	Контактная работа /ИКР/	8	0,25	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Э4	

#### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Тонкопленочные структуры в электронике»)

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
	6.1. Рекомендуемая литература						
		6.1.1. Основная литература					
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС			
Л1.1	Чижиков А.Е.	Физические основы электронной техники и технологии : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2000,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/1273			
Л1.2	Чижиков А.Е.	Основы технологии электронной компонентной базы : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2018,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/1844			

No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л1.3	Чижиков А.Е.	Физические основы электронной техники : Метод.указ.к практ.занятиям	Рязань, 1995, 20c.	, 1
Л1.4	Перелыгин А.И., Маслов А.А., Туркин Ю.А.	Конструкции ИМС и технология тонких пленок : Метод.указ.к лаб.работам	Рязань, 1997, 36c.	, 1
Л1.5	Васильев, В. Ю.	Технология тонких пленок для микро- и наноэлектроники : учебное пособие	Новосибирск: Новосибирски й государственн ый технический университет, 2019, 107 с.	978-5-7782- 3915-9, https://www.i prbookshop.r u/98748.html
Л1.6	Антоненко С. В.	Технология тонких пленок: учебное пособие для вузов	Москва: НИЯУ МИФИ, 2008, 104 с.	978-5-7262- 1036-0, http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_id=75918
	<u> </u>	6.1.2. Дополнительная литература	1	1
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Коротченко В.А., Молчанов Ю.К., Соломенникова В.С., Чижиков А.Е.	Технология материалов и изделий электронной техники : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/2271
Л2.2	Чижиков А.Е.	Исследование и разработка путей повышения качества газоразрядных индикаторных панелей: Автореферат	Рязань, 1999, 38c.	, 1
Л2.3	Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А.	Физика низкоразмерных систем: Учеб.пособие	СПб.:Наука, 2001, 155с.	5-02-024966- 1, 1
	<u>I</u>	6.1.3. Методические разработки		1
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС

№ Авторы, составители		ы, составители Заглавие		Количество/ название ЭБС	
ЛЗ.1	Амиров И. И., Артамонова Е. А., Балашов А. Г., Бардушкин В. В., Белов А. Н., Беспалов В. А., Бобринецкий И. И., Боргардт Н. И., Вернер В. Д., Волков Р. Л., Гаврилов С. А., Галперин В. А., Герасименко А. Ю., Голишников А. А., Горбацевич А. А., Громов Д. Г., Дюжев Н. А., Егоркин В. И., Звездин А. К., Земляков В. Е., Кицюк Е. П., Ключников А. С., Красников Г. Я., Красюков А. С., Крупкина Т. Ю., Кузнецов А. Е., Лавров И. В., Лебедев Е. А., Лукичев В. Ф., Мазуркин Н. С., Морозов Р. А., Неволин В. К., Плис В. И., Плохов Д. И., Подгаецкий В. М., Попков А. Ф., Попов А. И., Путря М. Г., Рощин В. М., Румянцев А. В., Савельев М. С., Сауров А. Н., Сетличный В. А., Селищев С. В., Силибин М. В., Солнышкин А. В., Стемпковский А. Л., Терещенко С. А., Тимошенков В. П., Тимошенков В. П., Тимошенков В. Б., Яковлева Е. Н., Чаплыгин Ю. А., Чиненков М. Ю., Шевяков В. И., Юров А. С., Яковлев В. Б., Яковлева Е. Н., Чаплыгин Ю. А.	Нанотехнологии в электронике-3.1	Москва: Техносфера, 2016, 480 с.	978-5-94836- 423-0, http://www.ip rbookshop.ru/ 58864.html	
Л3.2	Под ред.Чаплыгина Ю.А.	Нанотехнологии в электронике	М.:Техносфер а, 2005, 448c.	5-94836-059- 8, 1	
Л3.3	РРТИ;Науч.рук.Чиж иков А.ЕТема N 16- 88;N ГР У52770/8003164;Инв. N T58229	Создание состава и методов активирования толстопленочного эмиссионного покрытия катодов газоразрядных индикаторов : Отчет о НИР (Закл.)	Рязань, 1989, 144с.	, 1	

No	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС		
Л3.4	Неволин В.К.	Зондовые нано	технологии в электронике	М.:Техносфер а, 2005, 152с.	5-94836-054- 7, 1		
	6.2. Перечо	ень ресурсов и	нформационно-телекоммуникационной (	сети "Интернет"	L		
Э1	Сайт кафедры промыш	ленной электро	ники РГРТУ				
Э2	Система дистанционно	го обучения РГ	РТУ				
Э3	Информационная образовательная среда РГРТУ						
Э4	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»						
Э5	Электронно-библиотеч	ная система изд	дательства «Лань»				
	•		ого обеспечения и информационных спр ободно распространяемого программного отечественного производства		исле		
	Наименование		Описа	ние			
Операн	ционная система Window	S	Коммерческая лицензия				
Adobe	Acrobat Reader		Свободное ПО				
LibreOffice Свободное ПО							
Академ 2009	ическая версия паке	та LabVIEW	Свободное ПО				
Micro-C	Cap 12		Свободное ПО				
MathCA	AD		Коммерческая лицензия				
		6.3.2 Переч	ень информационных справочных сист	ем			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
	1	209 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, компьютерный класс Специализированная мебель (21 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ		
	2	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.		

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Тонкопленочные структуры в электронике»)

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru

Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru

6.3.2.1

6.3.2.2

		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ				
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ	<b>05.07.24</b> 10:43 (MSK)	Простая подпись		
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ	<b>05.07.24</b> 10:43 (MSK)	Простая подпись		
ПОДПИСАНО НАЧАЛЬНИКОМ УРОП	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Ерзылёва Анна Александровна, Начальник УРОП	<b>05.07.24</b> 11:52 (MSK)	Простая подпись		